

УДК 530.1.539.2

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ВОЛНЫ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

С. И. Ханкина, В. М. Яковенко

Исследуются нелинейные свойства плазменных колебаний в полупроводниковой пленке. Показано, что слабые нелинейности, связанные с неквадратичным законом дисперсии электронов проводимости, могут приводить к образованию солитонов огибающей. Это явление имеет пороговый характер и зависит от соотношения между амплитудой волны и начальной шириной импульса. Исследована неустойчивость нелинейных плазменных волн относительно поперечных возмущений.

Для волн конечной амплитуды одновременное действие процессов, связанных с дисперсией среды и нелинейностями, может привести к образованию солитонов, если эти процессы компенсируют друг друга. В настоящее время солитоны различной природы обнаружены во многих диспергирующих средах: в плазме, полупроводниках, ферромагнетиках и антиферромагнетиках и т. д. [1-4].

Целью предлагаемой работы является изучение влияния нелинейных эффектов на распространение плазменных колебаний в тонкой полупроводниковой пластине. Рассматриваются нелинейности, связанные с неквадратичным законом дисперсии носителей тока. Этот механизм может оказаться основным в узкозонных полупроводниках (например в InSb и PbTe), в которых закон дисперсии электронов имеет вид [5]

$$\mathcal{E} = (1/2) [(\epsilon_g^2 + \epsilon_g p^2/m)^{1/2} - \epsilon_g], \quad (1)$$

p — квазиимпульс, m — эффективная масса электрона вблизи дна зоны проводимости, ϵ_g — ширина запрещенной зоны.

В этом случае в уравнении движения электронов появляются нелинейные члены, которые соответствуют эффектам самовоздействия волн: изменению закона дисперсии, самофокусировке и т. д. Следует отметить, что трехволновое взаимодействие плазменных колебаний типа распада или слияния невозможно, так как для них одновременно не выполняются законы сохранения энергии и импульса.

Электромагнитные свойства полупроводниковой пластины описываются уравнениями Максвелла и гидродинамики. Для потенциальных колебаний

$$\text{rot } \mathbf{E} = 0, \quad \text{div } \epsilon_0 \mathbf{E} = 4\pi en; \quad (2)$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \text{div}(n_0 \mathbf{v}) = 0, \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E}, \quad (3)$$

$$\mathbf{p} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - v^2/v_n^2}}, \quad v_n^2 = \epsilon_g/2m,$$

e — заряд электрона, \mathbf{v} — скорость, n — отклонение концентрации от равновесного значения n_0 , ϵ_0 — диэлектрическая постоянная решетки.

Нелинейность в полупроводнике предполагается слабой, так что $v^2/v_n^2 \ll 1$.

Если система координат выбрана таким образом, что плоскости $y=0$, $y=a$ являются границей раздела полупроводник — вакуум, то выполняются следующие граничные условия:

на плоскости $y = a$ —

$$E_{x1} = E_{x2}, \quad (4)$$

$$\frac{\partial E_{y1}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E_{y2}}{\partial t} + 4\pi en_0 v_{y2},$$

на плоскости $y=0$ —

$$E_{x2} = E_{x3}, \quad (5a)$$

$$\frac{\partial E_{y3}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E_{y2}}{\partial t} + 4\pi en_0 v_{y2}.$$

Здесь индексы «1», «3» относятся к вакууму ($y > a$ — среда «1», $y < 0$ — среда «3»), индекс «2» — к полупроводнику ($0 \leq y \leq a$).

Зависимость всех переменных величин от координат и времени представим в виде $\mathbf{E}, \mathbf{v} \sim \exp[i(k_x x + k_y y - \omega t)]$. В направлении оси Oz система однородна. Воспользовавшись условиями излучения при $y = \pm \infty$ и уравнениями (2), перепишем граничные условия таким образом, чтобы в них вошли величины, характеризующие только полупроводник:

при $y = 0$ —

$$i \frac{\partial E_{x2}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E_{y2}}{\partial t} + 4\pi en_0 v_{y2},$$

при $y = a$ —

$$-i \frac{\partial E_{x2}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E_{y2}}{\partial t} + 4\pi en_0 v_{y2}. \quad (5b)$$

Из этих соотношений следует, что в полупроводниковой пластине существуют две независимые ветви плазменных колебаний [6]

$$\text{cth}(|k_x|a/2) + \varepsilon(\omega) = 0; \quad (6a)$$

$$\text{th}(|k_x|a/2) + \varepsilon(\omega) = 0 \quad (7a)$$

($k_y^2 = -k_x^2$, $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 - \omega_0^2/\omega^2$, $\omega_0^2 = 4\pi e^2 n_0/m$), которые при $a \rightarrow \infty$ имеют общую предельную частоту поверхностных плазменных колебаний ($1 + \varepsilon(\omega) = 0$).

Если полупроводниковая пластина тонкая и ее толщина меньше длины волны ($|k_x|a \ll 1$), то*

$$\omega^2 = \omega_0^2 \frac{|k_x|a}{2} \left(1 - \frac{\varepsilon_0 |k_x|a}{2} \right); \quad (6b)$$

* Волны аналогичного вида с частотой активации существуют вблизи экситонных полос поглощения. Действительно, если $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2 - \omega_{01}^2}$, то из (6a) при

$$|k_x|a \ll 1 \quad \omega^2 = \omega_{01}^2 + \frac{\omega_0^2 |k_x|a}{2}.$$

$$\omega^2 = \frac{\omega_0^2}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{|k_x|a}{2\epsilon_0} + \frac{k_x^2 a^2}{4\epsilon_0^2} \right), \quad \epsilon_0 |k_x| a \ll 2. \quad (76)$$

Таким образом, в этом случае дисперсия носит геометрический характер, она связана с конечными размерами образца. При $a \rightarrow 0$ колебания (66) переходят в двумерный поверхностный плазмон, если величина $n_0 a$ имеет конечный предел, равный поверхностной концентрации. В тонких пленках в силу неравенства $|k_x| a \ll 1$ в волне (66) компоненты v_y и E_y малы по сравнению с компонентами v_x и E_x ; в волне (76), наоборот, $v_x \ll v_y$, $E_x \ll E_y$. Потоки энергии в этих волнах направлены в противоположные стороны, так как их групповые скорости $v_{гр} = \partial\omega/\partial k_x$ разных знаков.

Слабая нелинейность в уравнениях движения приводит к зависимости частоты и фазовой скорости от амплитуды колебаний:

$$\omega^2 = \omega_0^2 \frac{|k_x| a}{2} \left(1 - \frac{\epsilon_0 |k_x| a}{2} \right) \left(1 - \frac{3}{2} \frac{|\varphi|^2}{v_n^2} \right); \quad (8a)$$

$$\omega^2 = \frac{\omega_0^2}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{|k_x| a}{2\epsilon_0} + \frac{k_x^2 a^2}{4\epsilon_0^2} \right) \left(1 - \frac{3}{2} \frac{|\varphi|^2}{v_n^2} \right), \quad (86)$$

φ — амплитуда скорости в каждой из ветвей. Предполагается, что она мало меняется на расстояниях порядка длины волны и за время порядка колебаний на основной гармонике (высшие гармоники, возникающие из-за нелинейности, считаются малыми), $\varphi = \varphi(x - v_{гр} t, t)$.

В [1] изложен метод, позволяющий на основании нелинейного дисперсионного уравнения построить уравнение Шредингера с кубической нелинейностью, описывающее эволюцию комплексной амплитуды плоской монохроматической волны, частота и волновой вектор в которой связаны законом дисперсии (66) или (76). Это уравнение имеет вид

$$i \frac{\partial \varphi}{\partial \tau} + \alpha \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi^2} - \beta |\varphi|^2 \varphi = 0, \quad (9)$$

τ, ξ — переменные, связанные с t и x соотношениями $\tau = t, \xi = x - v_{гр} t$.

В выражении (9)^{*} $\alpha = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \omega}{\partial k_x^2}, \beta = \frac{\partial \omega}{\partial |\varphi|^2}, \alpha_1 = -\frac{\omega_0^2 a^2}{32 \omega^3} = -\frac{\omega_0}{7|k_x|} \times$
 $\times \sqrt{\frac{a}{2|k_x|}}, \beta = -\frac{3}{4} \frac{\omega}{v_n^2}, v_{гр}^{(1)} = \frac{\omega_0}{2} \sqrt{\frac{a}{2|k_x|}}, \alpha_2 = -\frac{\omega_0 a}{32 \sqrt{\epsilon_0}},$

$\beta_2 = -\frac{3}{4} \frac{\omega_0}{v_n^2 \sqrt{\epsilon_0}}, v_{гр}^{(2)} = -\frac{\omega_0 a}{4 \sqrt{\epsilon_0}}$. Так как $\alpha_{1,2}$ и $\beta_{1,2}$ имеют одинаковые знаки, то однородное решение (9) $\varphi = \varphi_0 \exp(-i\beta|\varphi_0|^2 t)$ является устойчивым относительно малых продольных возмущений.

Задача Коши для уравнения (9) решается точно методом обратной задачи рассеяния [7].

* Уравнение (9) можно получить и иным способом, воспользовавшись процедурой, характерной для сред с геометрической дисперсией. В длинноволновом приближении $|k_x| a \ll 1$ все переменные величины слабо меняются по толщине полупроводниковой пластины. Поэтому их можно разложить в ряд по y вблизи $y=0$. Электрическое поле, скорость носителей тока и их производные по y при $y=0$ определяются друг через друга методом последовательных приближений из системы (2), (3), (5a) [1]. В результате в исходном дифференциальном уравнении появляются соответствующие члены, содержащие первые и вторые производные по x ,

Если для функции $\varphi(\xi, \tau)$ выполняются условия

$$|\varphi| \rightarrow |\varphi_0|, \quad \partial\varphi/\partial\xi = 0 \quad \text{при } |\xi| \rightarrow \infty, \quad (10)$$

то асимптотическим решением (9) при $\tau > \tau_{\text{пор}}$ является конечный набор солитонов, параметры которых (амплитуда, скорость) однозначно определяются дискретными собственными значениями λ системы уравнений:

$$\frac{\partial\psi_1}{\partial\xi} = i\lambda\psi_1 + i\varphi \sqrt{\frac{|\beta|}{2|\alpha|}} \psi_2, \quad (11)$$

$$\frac{\partial\psi_2}{\partial\xi} = -i\lambda\psi_2 + i\varphi \sqrt{\frac{|\beta|}{2|\alpha|}} \psi_1.$$

Выбираем в качестве начального возмущения прямоугольный импульс шириной $b = v_{\text{гр}} \tau$ и амплитудой φ_0 ($\varphi(\xi, 0) = 0$ при $-b/2 \leq \xi \leq b/2$, $\varphi(\xi, 0) = \varphi_0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$). Уравнения для определения дискретных собственных значений имеют вид

при $\text{tg } \lambda b > 0$ —

$$\pm \cos \lambda b = \lambda \sqrt{\frac{|\varphi_0|^2 |\beta|}{2|\alpha|}}, \quad \lambda^2 < \frac{|\varphi_0|^2 |\beta|}{2|\alpha|}, \quad (12)$$

при $\text{tg } \lambda b < 0$ —

$$\pm \sin \lambda b = \lambda \sqrt{|\varphi_0|^2 |\beta| / 2|\alpha|},$$

т. е. спектр собственных значений двукратно вырожден. Это означает, что образуются пары солитонов

Графический анализ (12) показывает, что процесс образования солитонов является пороговым. Пороговое значение амплитуды начального возмущения определяется условием

$$(\varphi_{0\text{пор}} b)^2 = \frac{\pi^2}{2} \frac{|\alpha|}{|\beta|}. \quad (13)$$

Для волны (8a) —

$$\varphi_{0\text{пор}}^{(1)} b = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \frac{v_n}{|k_x|},$$

для волны (8б) —

$$\varphi_{0\text{пор}}^{(2)} b = \frac{\pi}{4\sqrt{3}} v_n a.$$

С ростом φ_0 амплитуда солитонов и их число увеличиваются.

При заданной амплитуде можно определить $\tau_{\text{пор}}$, начиная с которого происходит процесс образования солитонов: $\tau_{\text{пор}}^{(1)} = \frac{\pi v_n}{\omega_0 |\varphi_0|} \times \sqrt{\frac{2}{3|k_x|a}}$, $\tau_{\text{пор}}^{(2)} = \frac{\pi v_n}{\sqrt{3} \omega_0 |\varphi_0|}$. Если амплитуда начального импульса меньше пороговой, то в результате пространственной дисперсии происходит рапывание начального возмущения.

Зная $\varphi_{0\text{пор}}$, легко определить пороговую мощность возбуждающей волны:

$$P_{\text{хпор}} = \frac{c}{8\pi} \iint dydz (E_y H_z^* + E_y^* H_z), \quad (14)$$

Для (8а) —

$$P_{x \text{ пор}} = \frac{1}{4\pi} \frac{2m^2}{3e^2} \omega^3 |\varphi_{0 \text{ пор}}|^2 \varepsilon(\omega) k_x L a^3 = \frac{\pi L k_x v^3 m^2 \omega v_n^2 \varepsilon(\omega)}{18e^2 \tau^2},$$

для (8б) —

$$P_{x \text{ пор}} = \frac{1}{4\pi} \frac{m^2 \omega^3}{e^2 k_x} |\varphi_{0 \text{ пор}}|^2 \varepsilon(\omega) L a = \frac{\pi L a m^2 \omega v_n^2 \varepsilon(\omega)}{12k_x e^2 \tau^2},$$

L — размеры пучка в направлении оси Oz .

При $a=10$ мкм, $L=1$ см, $\tau=20$ нс, $\omega_0/\sqrt{\varepsilon_0} \sim 10^{12}$ с⁻¹, $v_n \sim 10^8$ см/с ($\varepsilon_g=0,1$ эВ, $m=10^{-29}$ г) $P_{x \text{ пор}} \sim 10^{-2} \div 10^{-3}$ мВт, т. е. пороговые мощности возбуждающего сигнала невелики. Однако в приведенных выше рассуждениях не учитывалось затухание волн. Из условия малости затухания плазменных колебаний по сравнению с нелинейным изменением их частоты следуют более жесткие ограничения на амплитуду начального импульса. Так как для колебаний (8) $\Delta\omega = \frac{3}{4} \omega \frac{|\varphi|^2}{v_n^2}$, то должно выполняться неравенство $|\varphi_0|^2 > \frac{2}{3} \frac{v}{\omega} v_n^2$. При $v \sim 10^{11}$ с⁻¹, $v_n \sim 10^8$ см/с, $\omega \sim 10^{12}$ с⁻¹, $a=10$ мкм, $L=1$ см $|\varphi_0| \simeq 2,5 \cdot 10^7$ см/с и пороговые значения мощности значительно увеличиваются: $P_{x \text{ пор}} \sim 10-100$ мВт. Их можно уменьшить, увеличивая длительность импульса и уменьшая размеры L .

Для образования n пар солитонов должны выполняться неравенства

$$\frac{2|\alpha|}{|\beta|} (\pi n)^2 > (\varphi_0 b)^2 > \frac{2|\alpha|}{|\beta|} \pi^2 (n-1)^2. \quad (15)$$

При $n=1$, $t \rightarrow \infty$ (см. [4])

$$|\varphi(x, t)| = \varphi_0 \left\{ 1 - \frac{v^2}{\text{ch}^2(v/\sqrt{|\alpha|}) [x - (v_{\text{гр}} \pm \sqrt{|\alpha|\lambda})t]} \right\}^{1/2}, \quad (16)$$

$$v^2 = \frac{|\beta| |\varphi_0|^2}{2} - \lambda^2.$$

Можно показать, что если уравнение (9) дополнить членом $\frac{v_{\text{гр}}}{2|k_x|} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$, то однородное решение $\varphi = A_0 \exp(-i|A_0|^2 \beta \tau)$ для колебаний (8б) является устойчивым относительно малых поперечных возмущений огибающей, направленных вдоль оси Oz ($v_{\text{гр}}^{(2)} < 0$, $\beta_2 < 0$), и неустойчивым для колебаний (8а) ($v_{\text{гр}}^{(1)} > 0$, $\beta_1 < 0$).

Неустойчивость волны (8а) относительно поперечных возмущений приводит к нелинейной самоканализации. Если в продольном направлении волна имеет постоянную амплитуду ($\partial\varphi/\partial x = 0$), то уравнение (9) запишется следующим образом:

$$i \frac{\partial \varphi}{\partial \tau} + \frac{v_{\text{гр}}}{2|k_x|} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} - \beta_1 |\varphi|^2 \varphi = 0. \quad (17)$$

Его решение ищем в виде $\varphi = \varphi(z) e^{-i(\Omega t + \nu)}$, где $\varphi(z)$ — действительная величина, для которой выполняется условие $\varphi(z) \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow \infty$. В этом случае

$$\varphi(z, t) = \frac{A_0 \exp [(-iA_0^2/2)\beta_1 t + \gamma]}{\operatorname{ch} [A_0 (-\beta_1 |k_x|/v_{gp})^{1/2} z]}, \quad (18)$$

т. е. в направлении z распространяется солитон. Частота его пропорциональна квадрату амплитуды, а ширина $\Delta = \frac{1}{A} \left(-\frac{v_{gp}}{|k_x| \beta_1} \right)^{1/2}$. Энергия солитона пропорциональна $A_0^2 \Delta$ и тем больше, чем больше его амплитуда. Явление самоканализации также носит пороговый характер и зависит от соотношения между амплитудой и начальной шириной импульса. Если ширина начального пучка $-b_{\perp}$, то его амплитуда должна быть больше пороговой, определяемой соотношением

$$(A_{0\text{пор}} b_{\perp})^2 = \frac{\pi^2}{2} \left| \frac{v_{gp}}{|k_x| \beta} \right| = \frac{\pi^2 v_n^2}{6k_x^2}. \quad (19)$$

Это значение для $A_{0\text{пор}}$ следует из условия неустойчивости решения $\varphi = A_0 \exp(-i|A_0|^2 \beta t)$ относительно поперечных смещений [8]. При $b_{\perp} = 10^{-1}$ см, $k_x a \sim 10^{-1}$, $v_n \sim 10^8$ см/с $|A_{0\text{пор}}| \sim 10^7$ см/с.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Карпман В. И. Нелинейные волны в диспергирующих средах — М. Наука, 1973, с. 175.
- 2 Захаров В. Е., Мананов С. В., Новиков С. П., Питаевский Л. П. Теория солитонов метод обратной задачи — М. Наука, 1980, с. 320.
- 3 Звездин А. К., Попков А. Ф. — ЖЭТФ, 1983, 84, вып. 2, с. 606.
- 4 Лукомский В. П. — УФЖ, 1978, 23, № 1, с. 134.
- 5 Цидильковский И. М. Электроны и дырки в полупроводниках. — М. Наука, 1972, с. 640.
- 6 Ritchie R. H. — Surface science, 1973, 34, p. 1.
- 7 Захаров В. Е., Шабат А. Б. — ЖЭТФ, 1973, 64, вып. 5, с. 1627.
- 8 Беспалов В. И., Таланов В. И. — Письма в ЖЭТФ, 1966, 3, с. 471.

Институт радиотехники и электроники
АН УССР

Поступила в редакцию
5 июля 1983 г

NONLINEAR PLASMA WAVES IN BOUNDED SEMICONDUCTORS

S. I. Khankina, V. M. Yakovenko

Nonlinear effects of plasma oscillations in a semiconducting film are considered. It is shown, that the weak nonlinearities due to a nonquadratic energy-momentum relation of the conduction electrons may lead to formation of solitary waves of the pulse envelope. The effect is characterized by the existence of a threshold depending on the wave amplitude and the initial pulse width. The stability of the nonlinear plasma waves against transverse perturbations is analyzed.